

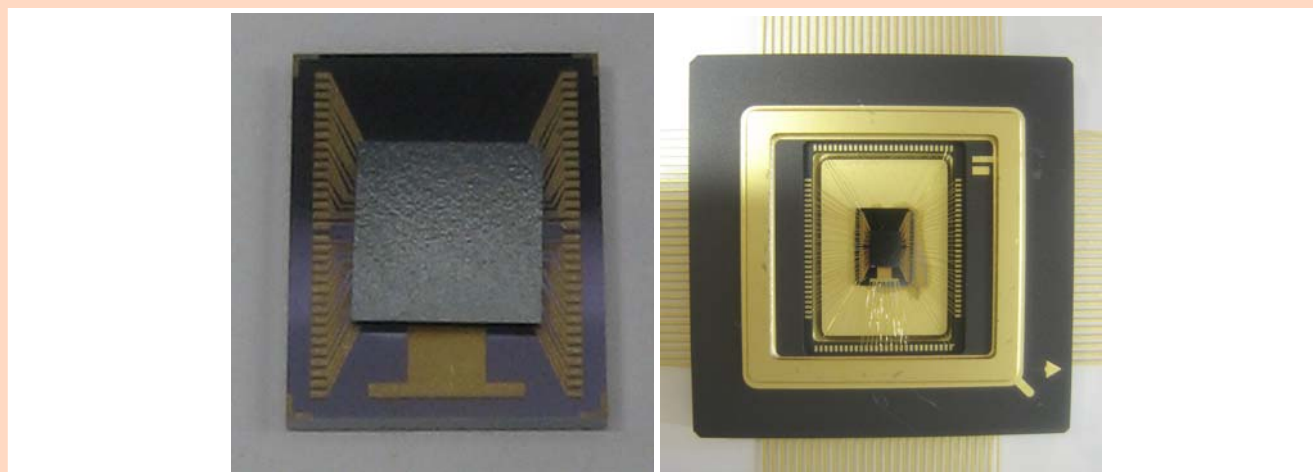
## 64-элементная (8×8) фотодиодная матрица

PD34BS 8×8

Длина волны в максимуме чувствительности	$\lambda_{\max}$	мкм	3.3÷3.35	@22 °C
Токовая чувствительность	$S_i$	A/Вт	≥1.3	
Темновое сопротивление	$R_0$	кОм	1÷2	
Обнаружительная способность	$D^*_{\lambda_{\max}}$	смГц <sup>1/2</sup> Вт <sup>-1</sup>	(0.6÷1)×10 <sup>10</sup>	
Быстродействие	$\tau$	нс	≤20	<sup>1</sup>

Обозначение изделия/ Обозначение корпуса	Чувствительная область, мм <sup>2</sup> / Размер чипа, мм	Вес изделия, грамм	Дополнительные оптические компоненты	Угол зрения, градус	Количество бракованных элементов, шт	Температурный диапазон эксплуатации, °C
PD34BS 8M/ 4233.112-A	64×(0.25×0.25) / 2.2×2.5	≤15	Крышка с сапфировым окном (опция)	~160	≤4	-60÷+80

Внешний вид изделия

Описание  
Преимущества

- Фоточувствительный элемент на основе гетероструктуры InAs/InAsSbP, выращенной на подложке n<sup>-</sup>-InAs;
  - Ввод излучения через свободную от контактов поверхность (флип-чип конструкция);
  - Индивидуальная адресация элементов. Общий минус;
  - Возможность монтажа на термоэлектрическом охладителе
- Не требует охлаждения;
  - Работа без внешнего смещения;
  - Одновременное детектирование быстропротекающих и непрерывных процессов;
  - Отсутствие деградации полупроводниковой структуры

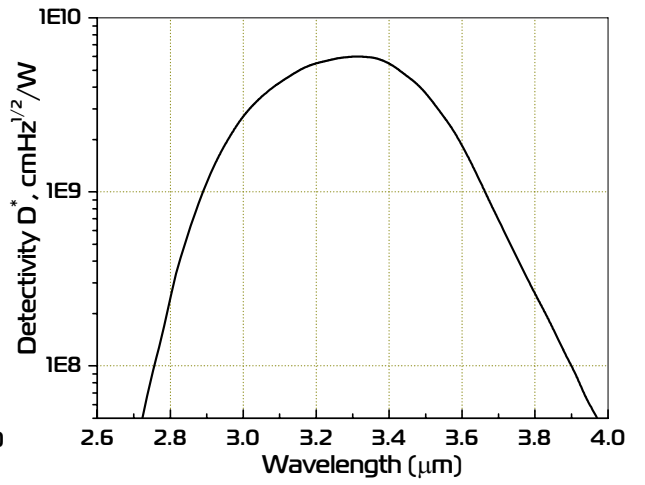
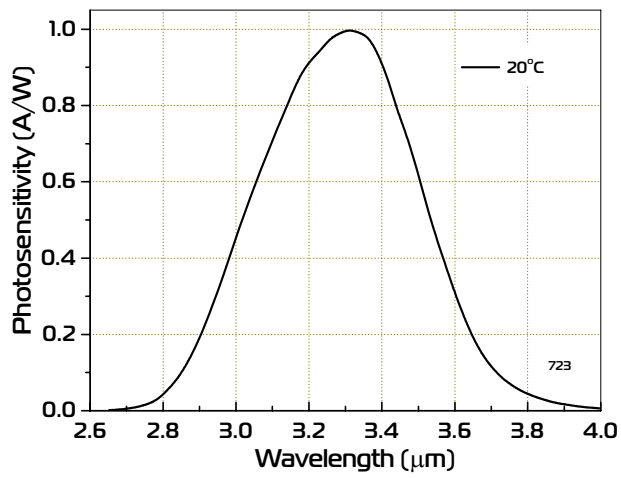
Примечания

1 – согласно оценкам

27.01.15



## Спектры фоточувствительности



## Примечания

Характер температурных изменений параметров фоточувствительности аналогичен приведенным для иммерсионных фотодиодов PD34

